

SD 335 . . . SD 340

SD 335/337/339 npn-, SD 336/338/340 pnp-Silizium-Epitaxie-Planar-Transistoren mittlerer Leistung für allgemeine NF-Anwendungen.

Als komplementäre Transistorpaare sind sie für NF-Leistungsendstufen und für Treiberstufen in NF-Verstärkern mit hohen Ausgangsleistungen verwendbar.

Bauform 6 TO126

Wärmewiderstand $R_{thja} \leq 110 \text{ K/W}$
 $R_{thjc} \leq 10 \text{ K/W}$

Grenzwerte: (gültig für den Betriebstemperaturbereich)

	SD 335/336	337/338	339/340	
$ U_{CBO} $	45	60	80	V
$ U_{CEO} $	45	60	80	V
$ U_{EBO} $		5		V
$ I_C $		1,5		A
$ I_{CM} $		2		A
$ I_B $		0,2		A
P_{tot} ($\vartheta_c \leq 25^\circ\text{C}$)		12,5		W
P_{tot} ($\vartheta_a \leq 40^\circ\text{C}$)		1		W
ϑ_j		150		$^\circ\text{C}$
ϑ_a		-55 . . . +125		$^\circ\text{C}$

Statische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$)

	SD 335/337/339			SD 336/338/340		
	min	typ	max	min	typ	max
$ U_{(BR)CBO} $ ($ I_C = 1 \text{ mA}$)						
SD 335/336	45			45		V
SD 337/338	60			60		V
SD 339/340	80			80		V
$ U_{(BR)CEO} $ ($ I_C = 50 \text{ mA}$)						
SD 335/336	45			45		V
SD 337/338	60			60		V
SD 339/340	80			80		V
$ U_{(BR)EBO} $ ($ I_E = 1 \mu\text{A}$)				5		V
$ I_{CBO} $ ($ U_{CB} = 30 \text{ V}$)		< 1	100		< 10	100 nA
$ I_{EBO} $ ($ U_{EB} = 5 \text{ V}$)		< 5 nA	10 μA		< 5 nA	10 μA
$ U_{CEsat}^1) $ ($ I_C = 500 \text{ mA}$, $ I_B = 50 \text{ mA}$)		200	500		280	500 mV
$ I_C = 100 \text{ mA}$, $ I_B = 10 \text{ mA}$)		70			80	mV
$ U_{BEsat}^1) $ ($ I_C = 500 \text{ mA}$, $ I_B = 50 \text{ mA}$)		870			930	mV
$ U_{BE}^1) $ ($ U_{CE} = 2 \text{ V}$, $ I_C = 500 \text{ mA}$)		830	1 000		835	1 000 mV
$ h_{21E} $ ($ U_{CE} = 2 \text{ V}$, $ I_C = 5 \text{ mA}$)	25	80		25	80	
$ U_{CE} = 2 \text{ V}$, Gruppe A	40	65	100	40	75	100
Gruppe B	63	110	160	63	115	160
$ I_C = 150 \text{ mA})^1)$ Gruppe C	100	150	250	100	140	250
$ h_{21E} $ ($ U_{CE} = 2 \text{ V}$, $ I_C = 500 \text{ mA})^1)$	25	90		25	108	

Paarungsbedingung:

$\frac{h_{21E1}}{h_{21E2}}$ ($|U_{CE}| = 2 \text{ V}$,
 $|I_C| = 150 \text{ mA})^1)$ $\leq 1,4$

Dynamische Kennwerte: ($\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$)

f_T ($|U_{CE}| = 10 \text{ V}$,
 $|I_C| = 50 \text{ mA}$, $f = 20 \text{ MHz}$) 50 125 75 210 MHz

¹⁾ Messung erfolgt impulsmäßig